



بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و
فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس
مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز،
شیراز، ایران.
۱۳۹۷ بهمن ۹-۱۱



بررسی پدیده جایگزیدگی اندرسون در انتشار امواج پلاسمون سطحی بر پایه گرافن

میلاد ثانی^۱، فاطمه صفرزاده^۱، محمود حسینی فرزاد^۱ و علی هاتف^۲

^۱ بخش فیزیک دانشگاه شیراز، پردیس ارم دانشگاه، میدان ارم، شیراز

^۲ آزمایشگاه فیزیک محاسباتی نیپسیسینگ، بخش علوم کامپیوتر و ریاضی، دانشگاه نیپسیسینگ، کانادا

چکیده - گرافن ساختاری دو بعدی با خواصی منحصر به فرد است. تحرک بالای حامل ها در گرافن باعث می شود که پلاسمون های گرافن اتلاف کم و محدودیت به سطح قابل ملاحظه ای داشته باشند. این امر گرافن را برای کاربردهای پلاسمونیک مناسب می کند. در این مقاله ساختاری متشکل از توری سیلیکونی و گرافن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که با ایجاد بی نظمی در ساختار پیشنهادی می توان مدهای پلاسمونی جدیدی ایجاد کرد که شدت قابل مقایسه ای نسبت به مدهای ساختار منظم دارند. این امر چنین ساختاری را کاندید مناسبی برای رزوناتورها و به طور کلی وسایل اپتوالکترونیکی می کند.

کلید واژه- تک لایه گرافن، پلاسمون سطحی، جایگزیدگی اندرسون

Investigation of Anderson localization phenomena in propagation of surface plasmon waves in graphene surface

Milad Sani¹, Fatemeh safarzadeh¹, Mahmood Hosseini Farzad¹ and Ali Hatf²

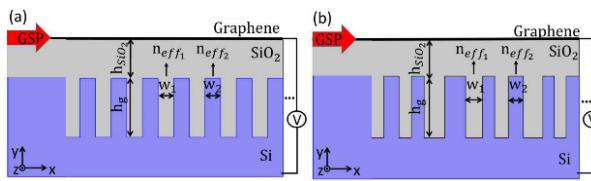
¹Department of physics, University of shiraz, Shiraz, Iran

²Nipissing Computational physics laboratory (NCPL), Department of computer science and
mathematics, nipissing university-north bay, canada

Abstract- graphene is a 2d structure with unique properties. High carrier mobility in graphene causes to graphene plasmons have low loss and considerable confinement to the surface. This suites graphene for plasmonic applications. In this article a structure consists of silicon grating and graphene were investigated. Results showing that with creating disorder in the proposed structure, we can create new localized plasmon modes that have comparable intensity than ordered structure modes. This makes such a structure as a suitable candidate for resonators and in general optoelectronic devices.

Keywords: Anderson localization, Graphene monolayer, Surface plasmon

است. این ساختار از یک تک لایه گرافن قرار گرفته بر روی یک توری سیلیکونی تشکیل شده است.



شکل ۱: تصویری شماتیک از نانوساختار توری-گرافن. a توری پرپودی. b توری رندم با درجه بی نظمی ۲۰٪.

در ساختار پرپودی که w_1 و w_2 که اندازه پهنا و فاصله میان دندانهاست، ۵۰ نانومتر است. فضای میان گرافن و توری از ماده SiO_2 پر شده است. h_g و h_{SiO_2} به ترتیب فاصله میان سطح توری تا لایه گرافن و ارتفاع دندان توری است و هر دو برابر با ۱۵۰ نانومتر در نظر گرفته شده اند. پلاسمون ها از سمت چپ ساختار تحریک می شوند. ساختار توری، موجب مدوله شدن رسانندگی گرافن و ضریب شکست مؤثر حرکت پلاسمون ها می گردد. برای بررسی خواص اپتیکی گرافن از رابطه ی کوبو^۱ مربوط به رسانندگی اپتیکی برای انتقال درون باندی و بین باندی استفاده می شود که ترم درون باندی (ترم اول) به دلیل کوچک بودن قابل صرف نظر است [۹]:

$$\sigma_g(\omega) = \frac{ie^2 k_B T}{\pi \hbar^2 (\omega + i\tau^{-1})} \left[\frac{\mu_c}{k_B T} + 2 \ln[\exp(-\frac{\mu_c}{k_B T}) + 1] + \frac{ie^2}{4\pi \hbar} \ln \left[\frac{2|\mu_c| - \hbar(\omega + i\tau^{-1})}{2|\mu_c| + \hbar(\omega + i\tau^{-1})} \right] \right] \quad (1)$$

در رابطه ۱، e بار الکترون، ω فرکانس فوتون در خلأ، $T = 300K$ دما، τ زمان واهلش تکانه و μ_c پتانسیل شیمیایی است که از رابطه $\mu_c = \hbar v_f (\pi n)^{1/2}$ به دست می آید که n چگالی دوپینگ گرافن و v_f سرعت فرمی است. همچنین $\tau = \mu \mu_c / (e v_f)^2$. $\mu = 20000 cm^2 V^{-1} s^{-1}$. $n = \epsilon_d \epsilon_0 V / eH$ که ϵ_d و ϵ_0 به ترتیب گذردهی نسبی SiO_2 و فضای آزاد هستند.

¹ kubo

مقدمه

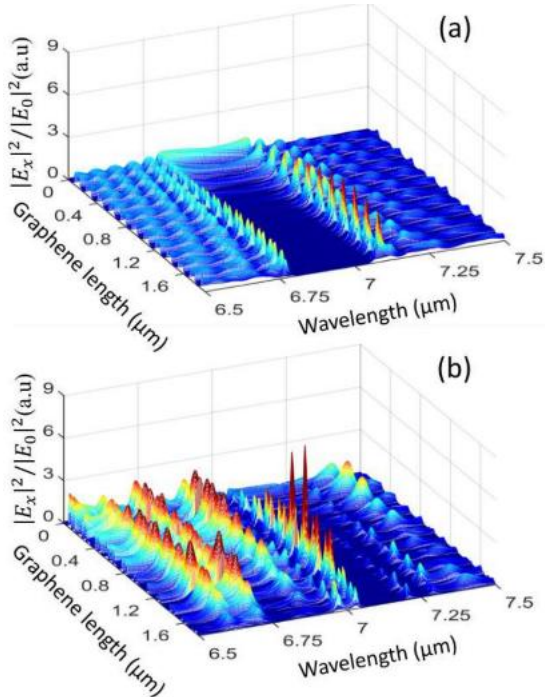
گرافن تک لایه ای دوبعدی از اتم های کربن است که با ویژگی های منحصر به فردی که از خود نشان می دهد افق های جدیدی برای طراحی نانوساختارهای پلاسمونیک باز می کند [۱]. پلاسمون های سطحی گرافن می توانند در محدوده ی طیفی فروسرخ نزدیک تا تراهرتز تحریک شوند. تحرک بالای حامل ها در گرافن موجب می شود که، پلاسمون های گرافن اتلاف کمی داشته باشند و شدیداً محدود به سطح باشند. به علاوه میزان تحرک حامل ها در گرافن توسط دوپ شیمیایی و اعمال ولتاژ قابل کنترل است. این خواص گرافن را کاندید مناسبی برای کاربرد در ساختارهایی نظیر مدارهای فوتونیک [۲]، سنسورها [۳] و ... می کند. محققان علاقه زیادی به مشاهده و مطالعه پدیده جایگزیدگی اندرسون امواج پلاسمون سطحی دارند و پژوهش هایی در این زمینه انجام شده است [۴-۶]. تداخل پراکندگی های چندگانه امواج پلاسمون سطحی در محیط های نامنظم می تواند منجر به رخداد پدیده جایگزیدگی اندرسون شود [۷]. گرافن به دلیل اتلاف کمتر پلاسمون های سطحی، محیط مناسب تری را برای رخداد جایگزیدگی اندرسون فراهم می آورد. اخیراً جایگزیدگی اندرسون پلاسمون های گرافن را در توری سیلیکونی نامنظم بر پایه ی گرافن نشان داده ایم [۸].

در این مقاله، ساختاری متشکل از یک لایه گرافن قرار گرفته بر روی توری سیلیکونی، به منظور بررسی رفتار پلاسمون ها در حضور بی نظمی شبیه سازی شده است. در ادامه تأثیر ایجاد بی نظمی با درجات مختلف بر مدهای پلاسمونی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

تئوری و ساختار شبیه سازی شده

در این مقاله با هدف بررسی اثر ایجاد بی نظمی بر رفتار پلاسمون ها، ساختاری به فرم شکل ۱ شبیه سازی شده

تابعی از طول موج و مکان روی سطح گرافن نشان می‌دهد که یکی از آن‌ها مربوط به ساختار پریودیک و دیگری مربوط به ساختار بی‌نظم با درجه‌ی بی‌نظمی ۲۵٪ است.



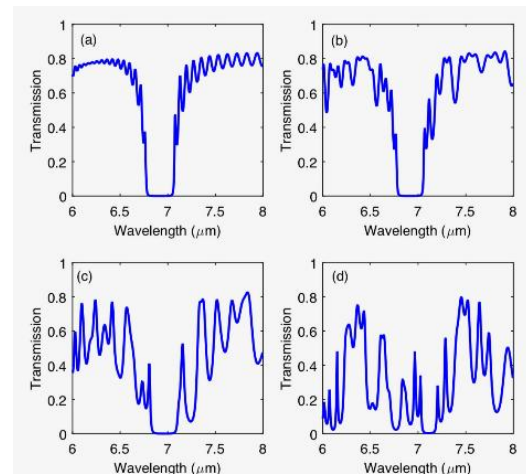
شکل ۳: توزیع شدت میدان الکتریکی به عنوان تابعی از طول موج و موقعیت برای یک ساختار پریودیک (a) و یک ساختار رندم با درجه بی‌نظمی ۲۵٪ (b).

این شکل به وضوح ایجاد مدهای پلاسمونی در مناطق ممنوعه را نشان می‌دهد. همچنین می‌توان جایگزیده شدن مدهای پلاسمونی در طول ساختار را نیز مشاهده کرد. نکته‌ی قابل توجه شکل این است که به دلیل رخداد پدیده‌ی جایگزیدگی اندرسون شدت مود می‌تواند به اندازه‌ی فاکتور ۹ نسبت به مدهای پلاسمونیک ساختار پریودیک افزایش یابد. چنین ساختاری می‌تواند به عنوان رزوناتوری با فاکتور کیفیت بالا مورد استفاده قرار گیرد. به علاوه این که مدهای پلاسمونی چنین ساختاری با تغییر ولتاژ اعمال شده میان گرافن و توری به طور دقیق قابل کنترل هستند. این مدهای پلاسمونی بسیار جایگزیده که قابل کنترل نیز هستند، افق‌های جدیدی برای پیشرفت وسایل اپتوالکترونیکی همچون فیلترهای فوتونیک، سنسورهای پلاسمونیک و مدولاتورهای فضایی نوری باز می‌کنند.

$V = 80\text{v}$ ولتاژ اعمال شده و H فاصله توری تا سطح گرافن است.

بحث و نتایج

برای رخداد پدیده‌ی جایگزیدگی اندرسون برای حرکت پلاسمون‌های سطحی، پهنای دندانه‌های توری را به صورت رندم انتخاب می‌کنیم (شکل ۱ سمت راست). در اینجا طیف عبور را مورد محاسبه قرار داده‌ایم. نمودار عبور برای یک ساختار منظم با توری پریودیک و سه ساختار با توری رندم با درجات بی‌نظمی ۵٪، ۱۵٪ و ۲۵٪ در شکل ۲ نشان داده شده است.



شکل ۲: طیف عبور گرافن بر پایه توری سیلیکونی براگ برای توری پریودیک (a) و توری‌های رندم با درجات بی‌نظمی ۵٪ (b)، ۱۵٪ (c) و ۲۵٪ (d).

شکل ۲ نشان می‌دهد که در نواحی ممنوعه مربوط به ساختار پریودیک مدهای پلاسمونیک رندم ایجاد می‌شوند. به علاوه باندهای ممنوعه نازک جدیدی در نواحی عبوری ساختار منظم به وجود می‌آیند. برای درک علت فیزیکی این رفتار، باید ماهیت تداخل امواج پلاسمونی را مورد توجه قرار داد. امواج پلاسمونی گرافن ضمن انتشار، تغییرات پریودیک و یا نامنظم توری را در قالب تغییر ضریب شکست مؤثر حس می‌کنند که این امر منجر به بازتاب‌های متعدد امواج پلاسمونی می‌گردد. برای طول‌موج‌های باند عبوری تداخل سازنده و برای طول موج‌های باند ممنوعه تداخل ویرانگر رخ داده است. شکل ۳، توزیع شدت میدان الکتریکی نرمالایز شده را به عنوان

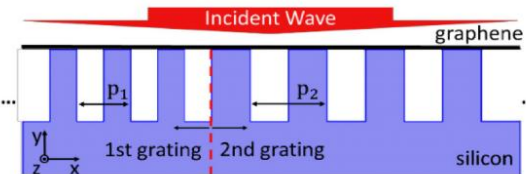
نتیجه گیری

در این مقاله، ساختاری بر پایه گرافن را پیشنهاد دادیم و به بررسی ایجاد بی نظمی بر حرکت پلاسمون ها در این ساختار پرداختیم. نتایج نشان دادند که با ایجاد بی نظمی می توان مدهای پلاسمونی را در مناطق طیفی ممنوعه مربوط به ساختار پریودیک ایجاد کرد؛ که این مدها علاوه بر قابل کنترل بودن، شدت قابل ملاحظه ای نسبت به مدهای پلاسمونی ساختار پریودیک دارند. بنابراین پدیده ی جایگزینی اندرسون در حرکت پلاسمون ها می تواند به طور قابل ملاحظه ای بازدهی ساختارهای پلاسمونیک بر پایه ی گرافن را افزایش دهد. این ساختار پیشنهادی می تواند کاندید مناسبی برای استفاده در رزوناتورها و سایر ادوات پلاسمونیک بر پایه گرافن از جمله فیلترها، سنسورها و مدولاتورها باشد.

مرجع ها

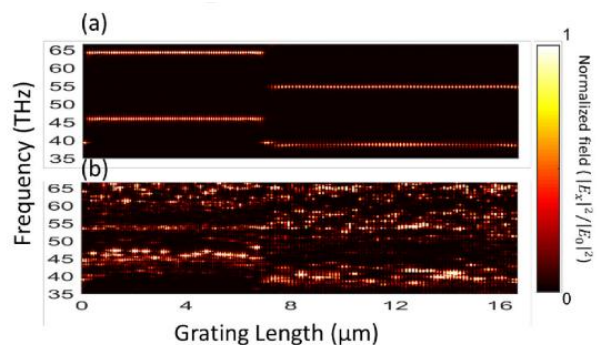
- [1] Cox J. D., Yu R. and Garc'ia de Abajo F. J., Phys. Rev. B, 96 ,045442(2017).
- [2] Kim J. and Choi S., Opt. Express, 19 ,24557, (2011).
- [3] Yu R., Cox J. D. and Garc'ia de Abajo F. J., Phys. Rev. Lett., 117 ,123904 (2016).
- [4] Grsillon. S, et al, Phys. Rev. Lett. 82 (22), pp.45204523 (1999).
- [5] Bozhevolnyi. S. I, Volkov. V. S. Leosson. K, phys. Rev. Lett. 89 (18), p.186801 (2002).
- [6] Rting, F, Phys. Rev. B, 83, 115447 (2011).
- [7] Sanchez-Gil J. A., Freilikher V., Yurkevich I. and Maradudin A. A., Phys. Rev. Lett., 80 ,948(1998).
- [8] Sani M. and Hosseini Farzad M., Phys. Rev. B, 97 ,85406(2018).
- [9] Falkovsky. L.A. and Pershoguba. S. S, Phys. Rev. B 76, 153410 (2007).

در ساختار دیگری دو توری به هم چسبیده را شبیه سازی کردیم که از بالا مورد تابش قرار می گیرد که $p_1=35$ و $p_2=50$ به ترتیب پریود توری اول و پریود توری دوم هستند (شکل ۴).



شکل ۴: نانوساختار با دو توری به هم چسبیده.

سپس در ساختار دو توری با تغییر پهنای دندانه ها بی نظمی ایجاد شده است. شکل ۵ توزیع شدت میدان الکتریکی روی سطح گرافن را در دو ساختار پریودیک (شکل ۵a) و بی نظم (شکل ۵b) نشان می دهد.



شکل ۵: توزیع شدت میدان الکتریکی برای ساختار دو توری به هم چسبیده به عنوان تابعی از فرکانس و طول در دو حالت پریودیک (a) و رندم (b).

همانگونه که از شکل ۵ استنباط می شود برای ساختار پریودیک، پلاسمون ها در دو فرکانس ۴۵٫۸ و ۶۴٫۱ تراهرتز مربوط به توری اول و دو فرکانس ۳۸٫۷ و ۵۴٫۸ تراهرتز مربوط به توری دوم تحریک می شوند. اما پس از ایجاد بی نظمی در ساختار دو توری، پلاسمون های جایگزیده تقریباً در تمام فرکانس ها از ۳۷ تا ۶۶ تراهرتز با شدت یک مرتبه بزرگی، بزرگ تر از پلاسمون های توری پریودیک، تحریک می شوند. اگر تعداد توری ها افزایش یابد، طیف فرکانسی پلاسمون های تحریک شده پهن تر می شود.